



보도시점 2025. 8. 28.(목) 11:00
< 8. 29.(금) 조간 >

배포 2025. 8. 28.(목)

전량 해외의존 탈출, 반도체 공급망 M&A 성사

- 에프엔에스테크사(社), 대만 아사히 램프 인수를 약 108억원에 인수
- 산업부 해외 M&A 지원사업 성과… 반도체 핵심부품 공급망 안정화 기대

산업통상자원부(장관 김정관, 이하 산업부)는 29일 투자연계형 기술확보 지원사업을 통해 국내 장비기업의 대만 반도체 부품 제조업체인 아사히 램프(ASAHI LAMP)社 인수를 지원했다고 밝혔다. 이번 인수 규모는 약 108억원이다.

아사히 램프社는 반도체 RTP(Rapid Thermal Processing, 급속 열처리) 및 EPI(Epitaxial Layer, 에피택셜 증착) 공정에 활용되는 텅스텐 할로젠 램프 제조기술*을 보유한 기업으로, Applied Materials(미국), TSMC(대만) 등에 납품 중이다.

* 고온에서도 광출력과 수명유지가 가능한 광원으로, 반도체 웨이퍼 열처리 공정장비에 사용

현재 고출력 반도체 공정용 램프는 국내 생산기반이 부재한 상황으로, 전량 해외에 의존 중이다. 이번 인수는 단기적으로 안정적 부품확보 및 시장 확대, 중장기적으로는 기술 내재화를 통한 국내 반도체산업 공급망 안정성과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

산업부와 한국소재부품장비투자기관협의회(KITIA)는 매물발굴, 실사 및 기술 평가 지원 등을 통해 우리 기업의 해외기술 확보를 지원하고 있다. 올해부터 공급망 전략수립 지원을 신설했으며 세액공제* 연장도 추진 중이다.

* '28년까지 소부장 관련 외국법인 인수시 인수금액의 5~10% 세액공제 연장 추진 중

산업부 나성화 산업공급망정책관은 “해외 M&A는 기술과 시장을 동시에 확보할 수 있는 제2의 R&D”라며, “우리 기업들께 정부의 지원을 적극 활용하여 해외기술 확보에 나서주실 것을 부탁드립니다.”고 밝혔다.

한편, 에프엔에스테크社는 지난 2013년에도 산업부의 지원을 받아 미국 InnoPad社를 인수하여 CMP PAD(연마용 패드) 기술을 확보, 현재 삼성전자 등 국내 주요 반도체 기업에 납품 중이다.

담당 부서	산업공급망정책관 소재부품장비개발과	책임자	과 장	고 현 (044-203-4920)
		담당자	사무관	박한기 (044-203-4927)



□ 사업개요

- 글로벌 공급망 안정성 증대를 목적으로 해외 소부장 핵심기술확보 및 공급망안정화 중심의 취득·활용을 위한 다양한 방식*의 해외기술확보 지원
 - * 인수합병(M&A), 소수지분투자, 합작법인설립, 특허권 확보 등 해외기업과 기술 투자기반 전략적 제휴방식인 광의의 M&A

□ 주요 지원내용

- (정보제공 및 매칭지원) 해외 소부장 핵심기술 보유 M&A 매물정보 제공 및 기술확보 전략 수립, 협력의사 타진, 추가 정보 발굴 등 매칭 지원
 - * 무료 정보제공 플랫폼 테크파인더(techfinder.or.kr) : 해외기업 정보 5천여개 수록
- (공급망안정화 지원) 환경규제·경제성 부족 등 대외의존도가 높은 핵심품목에 대해 공급망 안정화 전략수립* 지원(최대 1.5억원)
 - * 공급망 현황 및 리스크 진단, 대응전략 시나리오 설계, 대체 파트너 발굴 등
- (M&A 실사지원) M&A 추진과정에서 타겟기업의 기업가치 평가, 재무/영업 실사, 법률(계약) 자문비용 지원을 통해 조기 성사 지원(최대 4천만원)
- (세액공제 지원) 국내산업기반 및 해외의존도 등을 고려하여 소부장 관련 외국법인* 인수시 인수금액의 10%(중견 7%, 대기업 5%) 세액공제
 - * 조세특례제한법 제13조 3항에 따라 소부장 품목(핵심전략기술·경제안보품목 및 국가전략기술 관련 품목) 매출액이 전체 매출액의 50% 이상인 외국법인

지원구분	신청·접수	지원 내용	
정보제공매칭지원	▶ 테크파인더 온라인 신청	▶ M&A 매물제공·매칭지원	▶ 세제혜택인수자금 연계지원
공급망안정화	▶ 신청서류 제출·접수	▶ 전략수립 지원	▶ 세제혜택인수자금 연계지원
M&A실사지원	▶ 신청서류 제출·접수	▶ 기술자산종합평가	▶ 세제혜택인수자금 연계지원

□ 지원성과

- '21년 이후 인수합병, 합작법인설립, 지분투자 등 56건 성사

□ 반도체용 할로겐 램프

- 할로겐 램프는 고온에서도 광출력과 수명유지가 가능한 광원으로, 반도체 웨이퍼(wafer) 열처리 공정장비(RTP*, EPI** 등)에 사용

* RTP(Rapid Thermal Processing) : 고온에서 웨이퍼 표면을 짧은 시간내에 가열하여 전자를 삽입하는 공정

** EPI(Epitaxial Layer) : 웨이퍼 표면에 화학기상증착(CVD)을 통해 단결정 박막을 증착하는 공정

<참고> 반도체 8대공정과 RTP, EPI 공정적용>

단계	1	2	3	4
공정	웨이퍼제조	산화	노광(포토)	식각
설명	실리콘을 성장시켜 웨이퍼 제조 ※박막증착 웨이퍼 제조시 EPI 공정진행	웨이퍼 표면에 산화막을 형성하여 절연층 확보	감광액(포토레지스트)을 도포하고 회로 패턴을 노광·현상	불필요한 박막·산화막을 화학적·물리적으로 제거
단계	5	6	7	8
공정	증착&이온주입	배선	전기적 특성검사	패키징
설명	절연막·도전막을 증착하고, 전기적 특성을 부여 ※이온주입 후 RTP 어닐링으로 활성화	회로를 연결하는 금속층을 증착하고 패턴을 형성. 금속	패키징 전, 각 다이(Die)의 전기적 특성을 검사하여 선별	칩을 보호하고 외부와 전기적으로 연결하기 위해 패키지 작업

□ 시장규모 및 국내 기술수준

- 글로벌 반도체용 할로겐 램프 시장규모는 약 3천억원으로 추정되며 연평균 9~10%의 성장세 유지 中
- 반도체 할로겐 램프는 기술 진입장벽이 높고, 고신뢰성 인증이 요구되는 분야로, Ushio(日), Osram(獨) 등 해외기업 중심의 과점상태
 - 국내 소수 기업이 반도체용 램프를 생산 中이나, 고출력 할로겐 램프(고온안정성·정밀파장제어 등) 생산기업은 전무한 상황

□ 해외기술확보 시 기대효과

- 글로벌 웨이퍼 열처리 장비社의 요구사항에 부합하는 기술확보시, 반도체 장비용 할로겐 램프의 국산화 및 공급망 다변화 가능
 - 수입의존도 완화 및 확보된 기술 기반의 유사 광원 시장 확장 기대